Corso di ELETTRONICA INDUSTRIALE

INVERTITORI MONOFASE A TENSIONE IMPRESSA

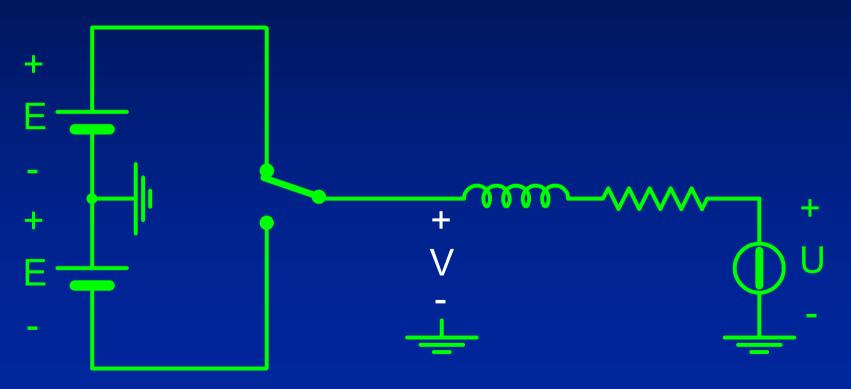
 Struttura e funzionamento dell'invertitore monofase di tensione a due livelli

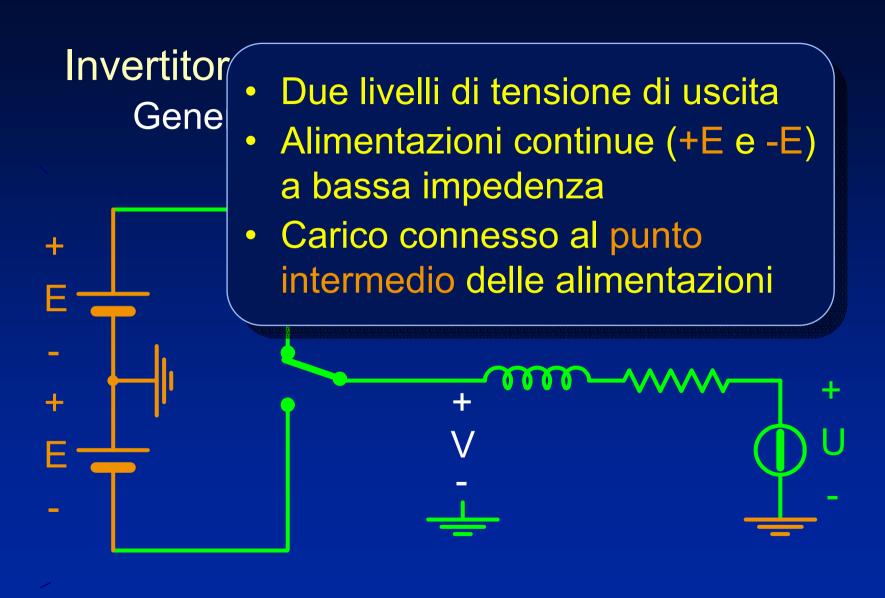
- Struttura e funzionamento dell'invertitore monofase di tensione a due livelli
- Metodi di modulazione a PWM analogici e digitali

- Struttura e funzionamento dell'invertitore monofase di tensione a due livelli
- Metodi di modulazione a PWM analogici e digitali
- Modulazioni a bassa frequenza di portante e ad onda quadra

- Struttura e funzionamento dell'invertitore monofase di tensione a due livelli
- Metodi di modulazione a PWM analogici e digitali
- Modulazioni a bassa frequenza di portante e ad onda quadra
- Componenti di potenza per invertitori

Invertitore di tensione monofase a PWM Generazione di due livelli di tensione: positivo e negativo





Invertitore di tensione monofase a PWM

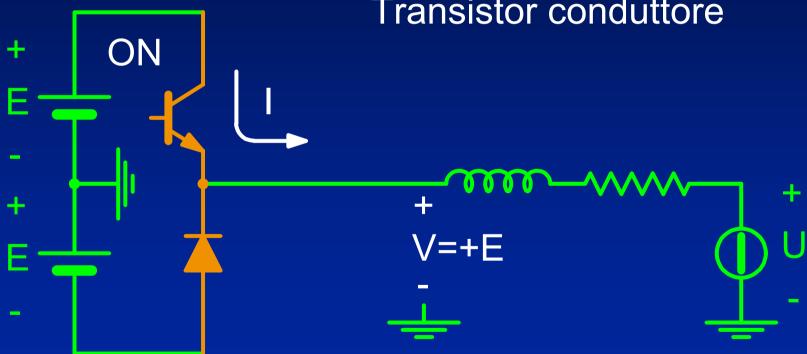
- Carico induttivo alla frequenza di modulazione
- Armoniche di modulazione nella corrente di uscita filtrate dal carico



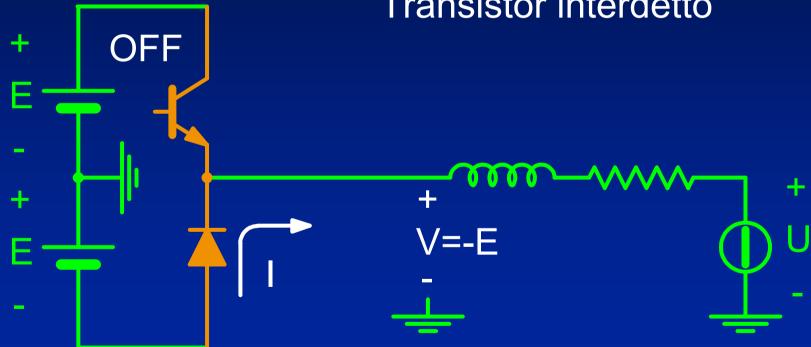
Invertitore di tensione monofase a PWM



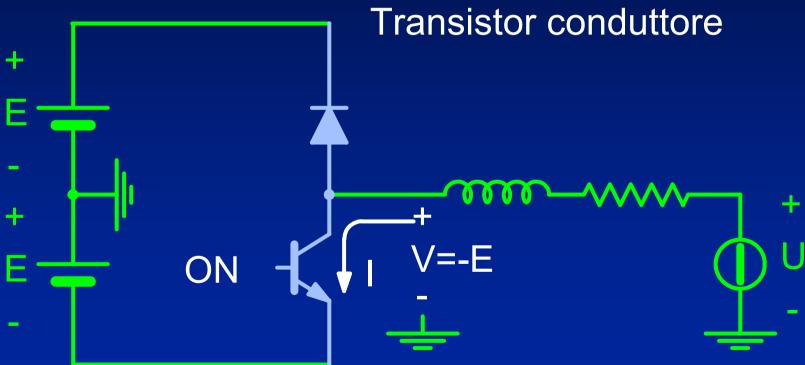
(A) Corrente di carico uscente Transistor conduttore



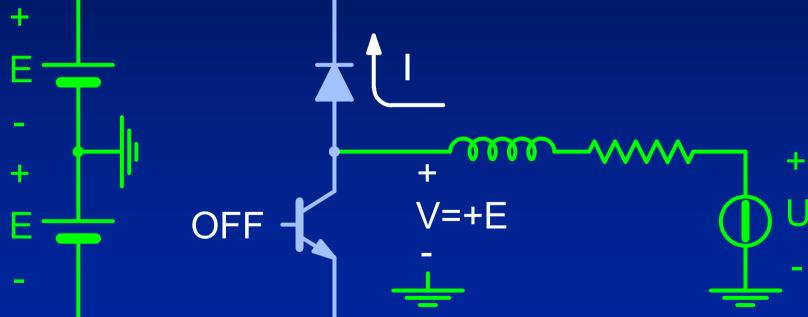
(A) Corrente di carico uscente Transistor interdetto



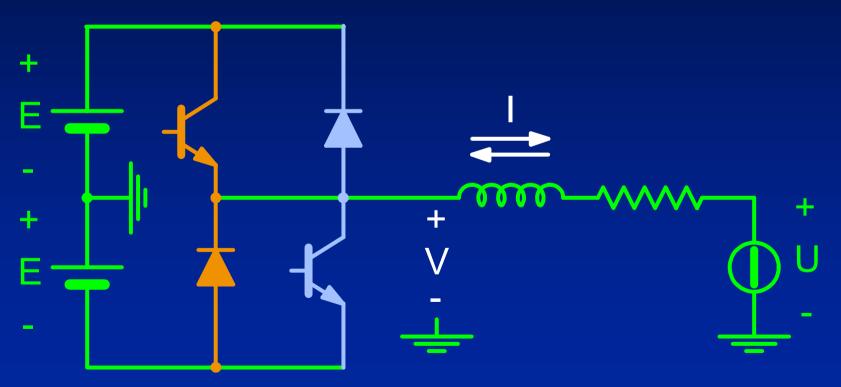
(B) Corrente di carico entrante

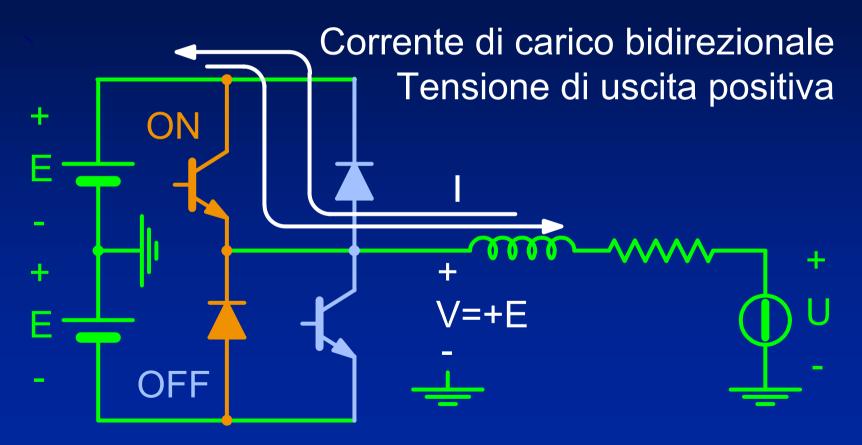


(B) Corrente di carico entrante Transistor interdetto

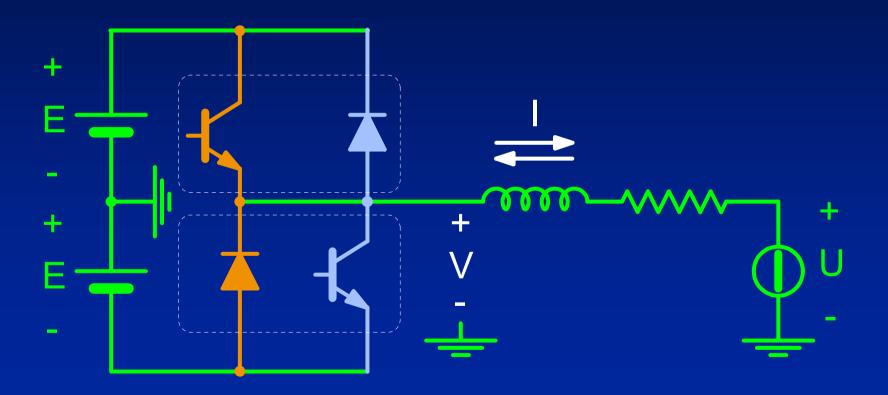


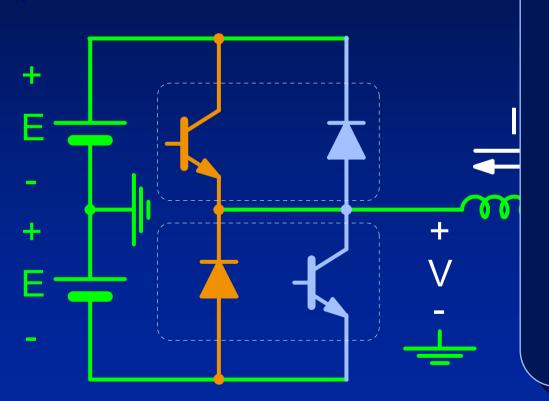
(A+B) Corrente di carico bidirezionale



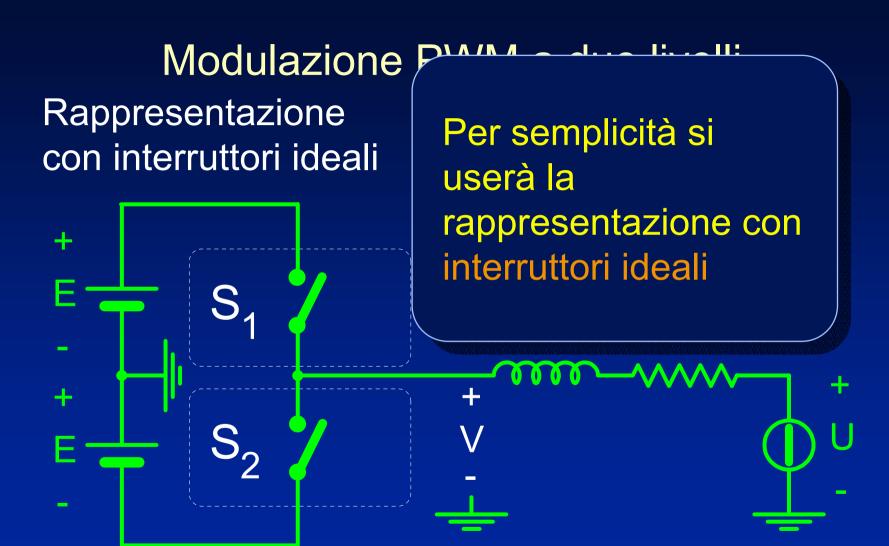


Corrente di carico bidirezionale Tensione di uscita negativa OFF V=-F





Ciascun transistor con il diodo connesso in parallelo costituisce un interruttore bidirezionale

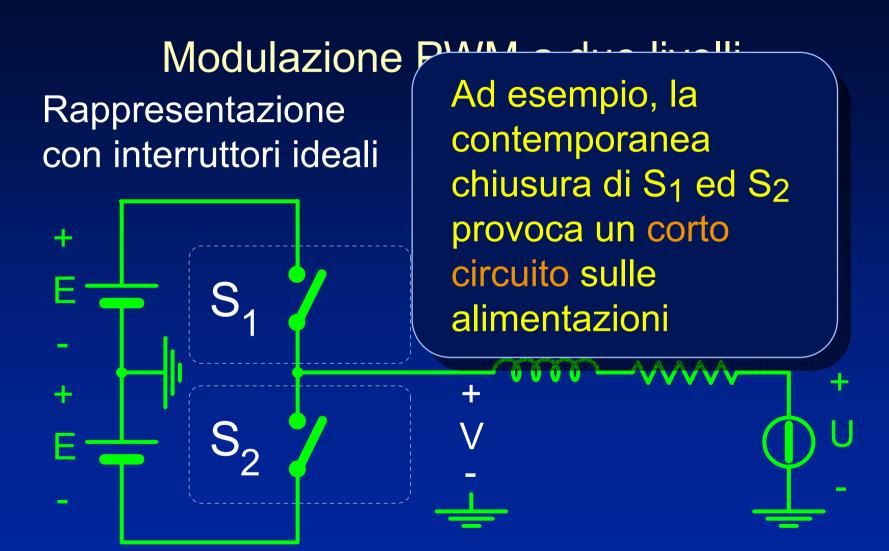


Tuttavia, la reale

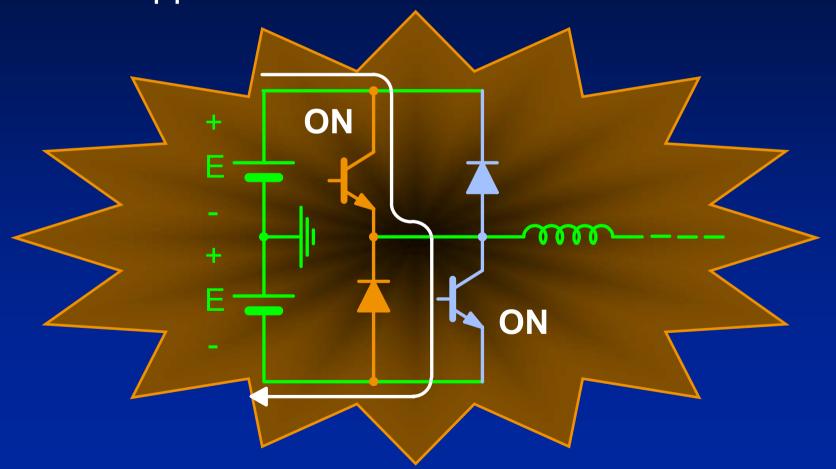
struttura degli

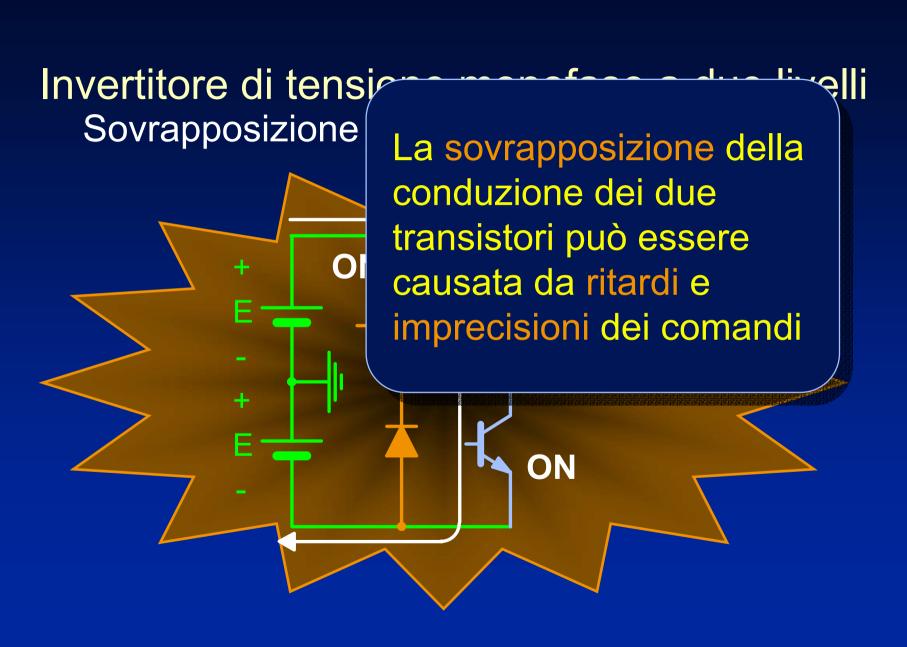
Rappresentazione con interruttori ideali

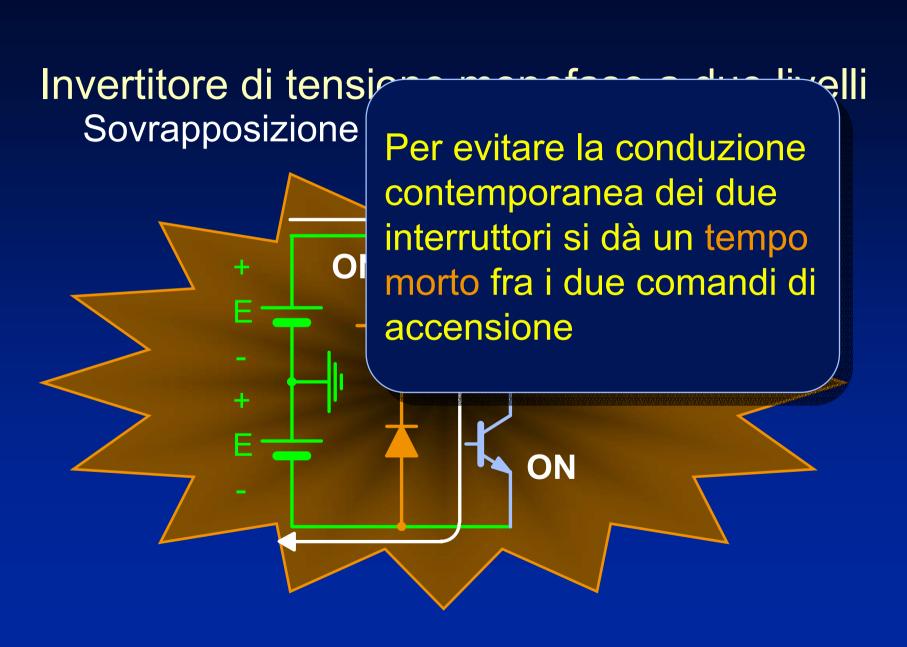
interruttori pone dei vincoli alle modalità di operazione



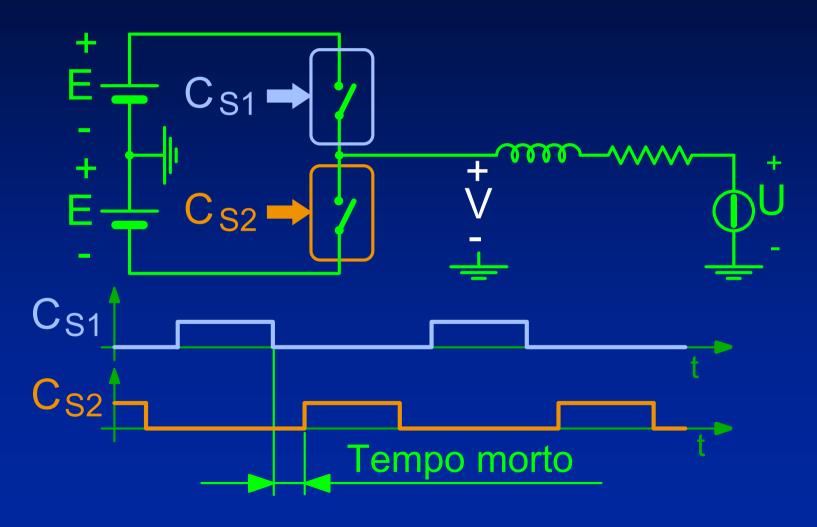
Invertitore di tensione monofase a due livelli Sovrapposizione di conduzione dei transistor

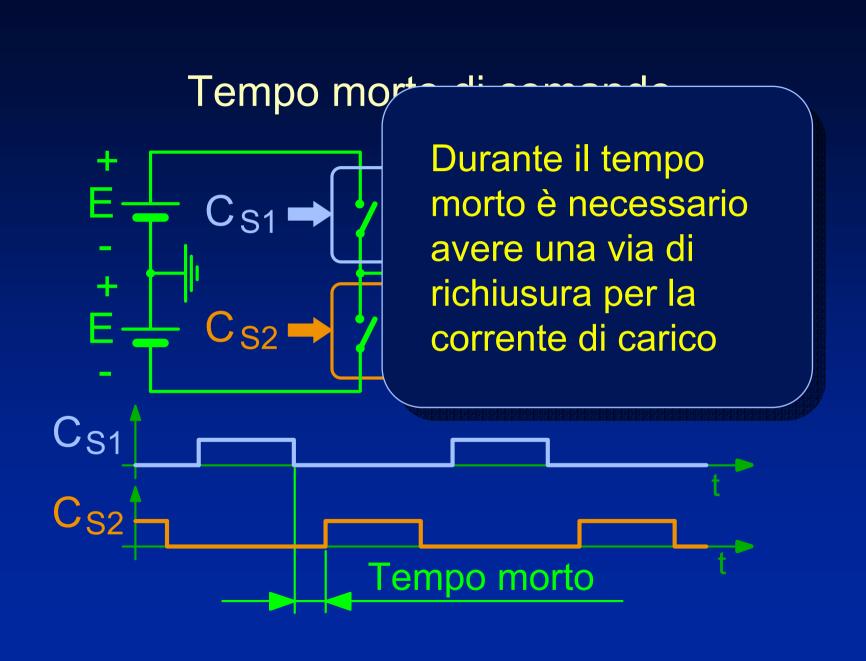




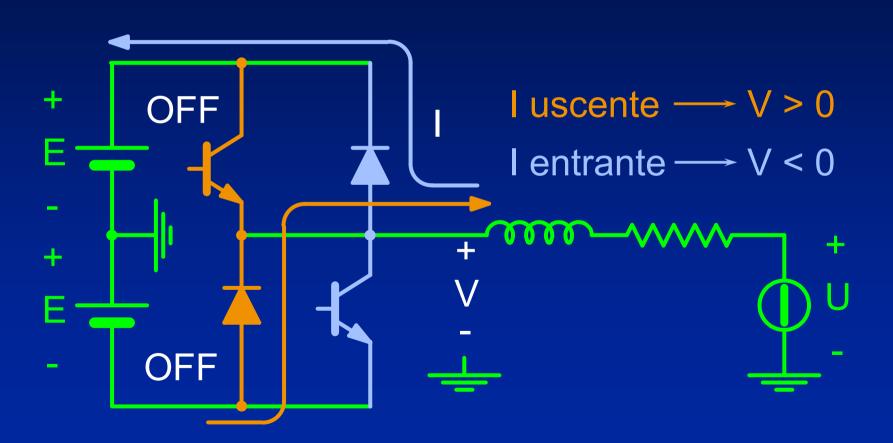


Tempo morto di comando





Conduzione dei diodi durante il tempo morto



nte La via di richiusura è assicurata dai diodi in antiparallelo. La tensione in uscita dipende dal verso della corrente I entrante $\longrightarrow V < 0$ OFF

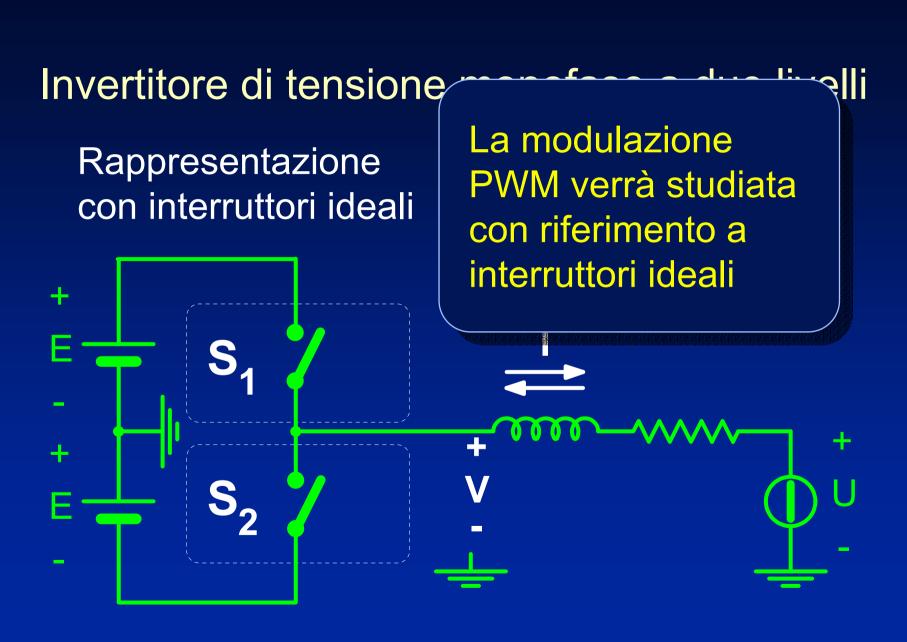
Invertitore di tensione monofase a due livelli

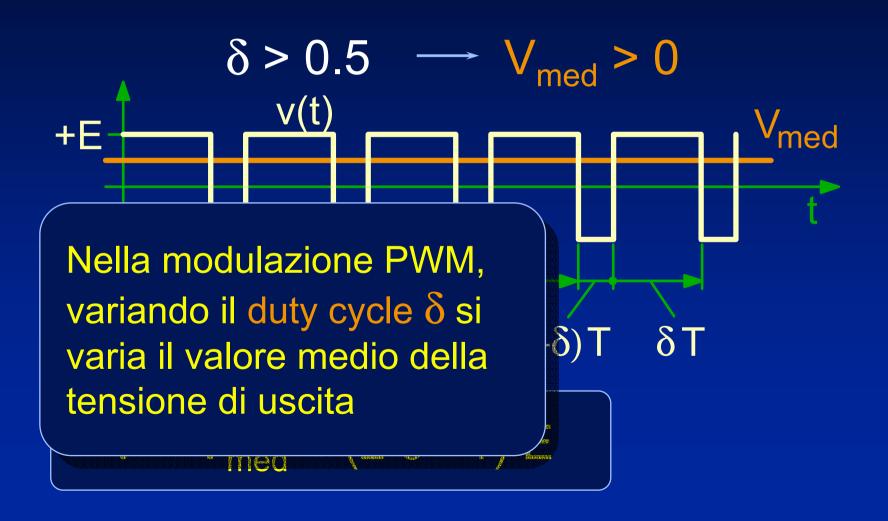
Stati dell'invertitore

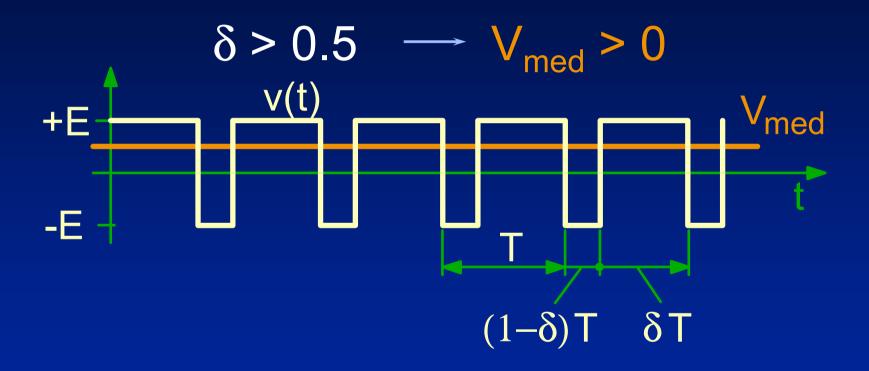
$$S_1 ext{ ON } S_2 ext{ OFF } \longrightarrow V = +E$$

 $S_1 ext{ OFF } S_2 ext{ ON } \longrightarrow V = -E$

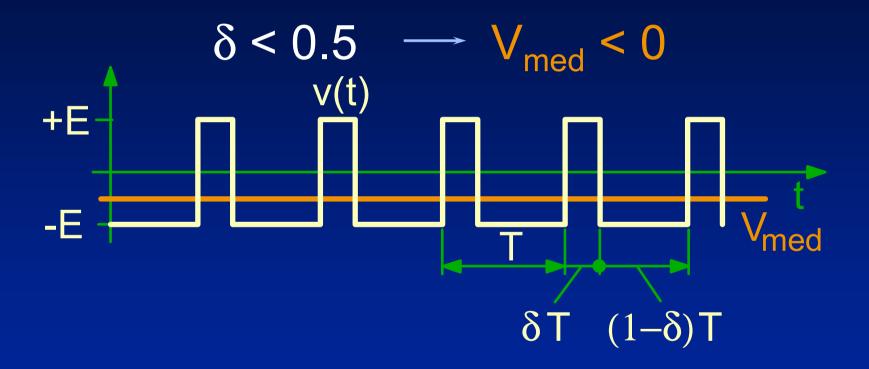
 S_1 OFF S_2 OFF \longrightarrow V dipende dal segno di I S_1 ON S_2 ON \longrightarrow NON AMMESSA







$$V = V_{med} = (2 \delta - 1) E$$



$$V = V_{med} = (2 \delta - 1) E$$

Nel complesso, variazioni del "duty cycle" (fattore di utilizzazione) δ da 0 a 1 generano una tensione media di uscita V variabile fra -E e +E

$$V = V_{med} = (2 \delta - 1) E$$

Si ottiene V=0 con δ =0.5

La PWM consente di far seguire a V_{med} una forma d'onda V^* assegnata, mediante variazioni nel tempo del valore di δ :

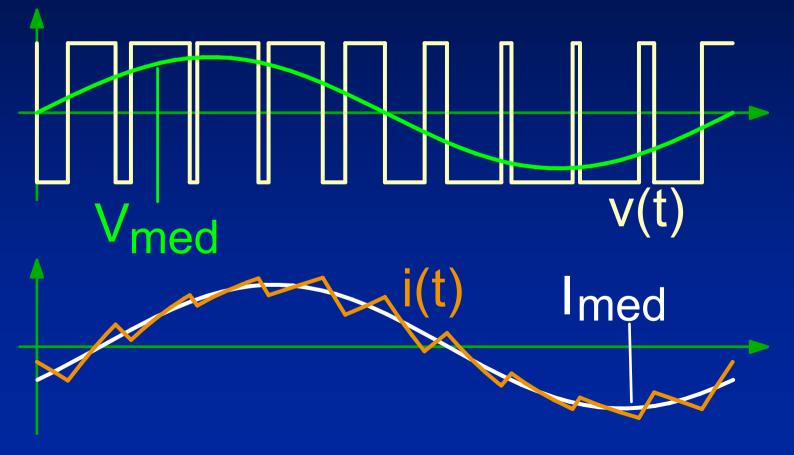
$$V = V_{med} = (2 \delta(t) - 1) E$$

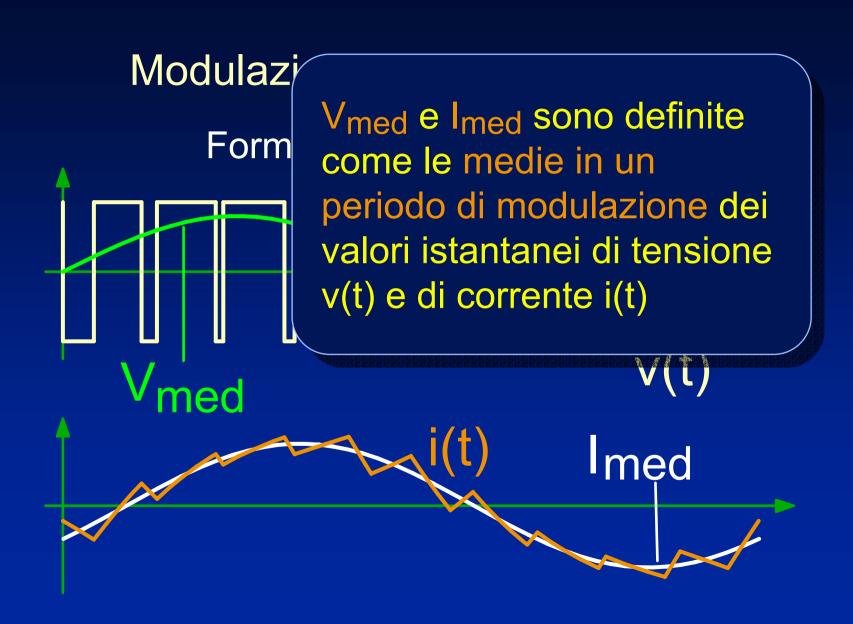
HIGU

Tensione di uscita variabile

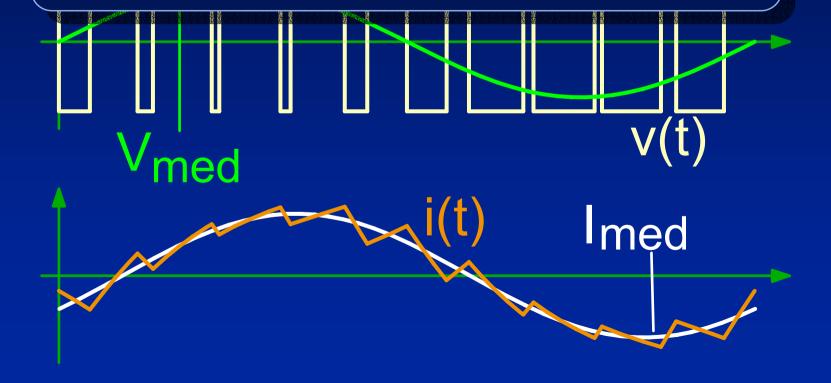
$$V = V_{med} = (2 \delta(t) - 1) E$$

Forma d'onda sinusoidale

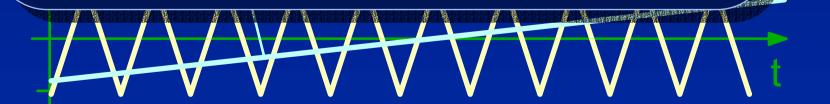




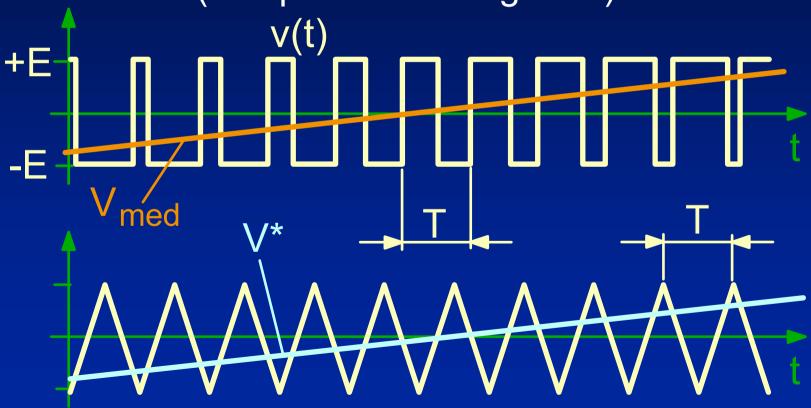
L'ondulazione di corrente intorno a I_{med} è ridotta dall'azione filtrante del carico

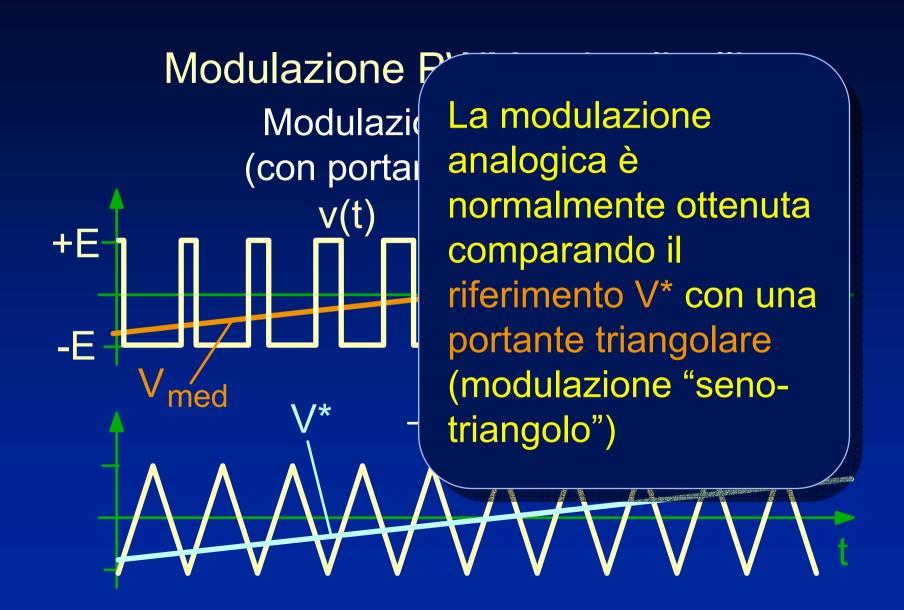


La generazione dei segnali di comando con il duty cycle δ(t) corrispondente ad una forma d'onda di riferimento V* può essere fatta per via analogica o per via digitale

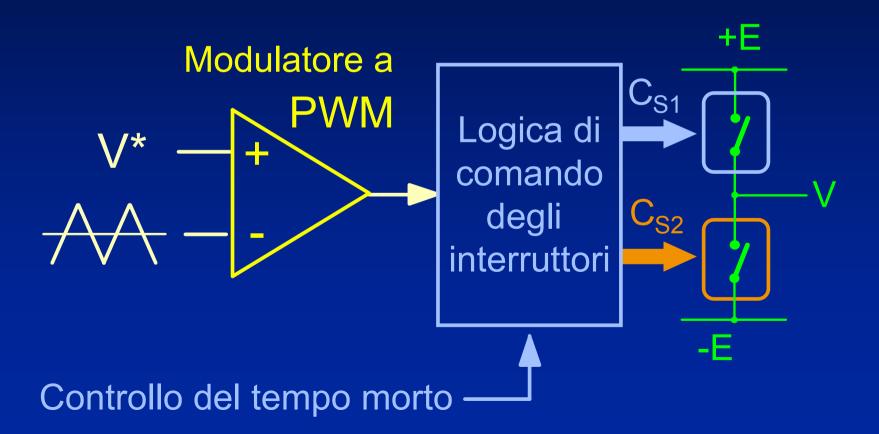


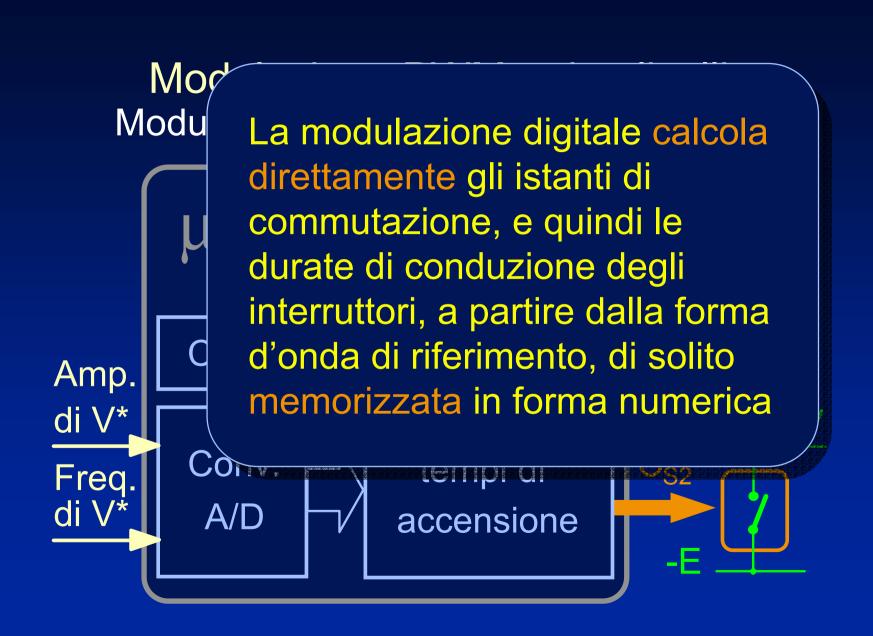
Modulazione analogica (con portante triangolare)



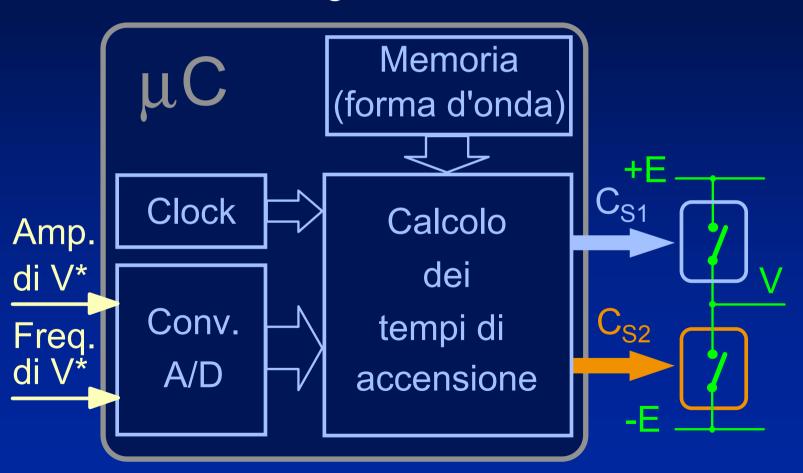


Modulazione analogica: schema a blocchi





Modulazione PWM a due livelli Modulazione digitale a microcontrollore



L'utilizzo di microcontrollori o di circuiti integrati dedicati (ASIC) consente una realizzazione compatta del controllo digitale

L'utilizzo di microcontrollori o di circuiti integrati dedicati (ASIC) consente una realizzazione compatta del controllo digitale

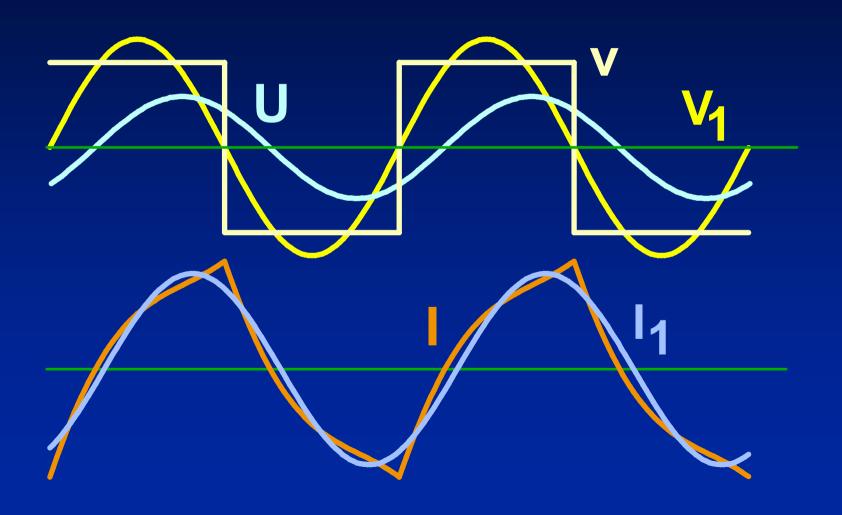
Secondo la tendenza attuale, si preferisce il controllo digitale per la sua affidabilità, per l'assenza di procedure di taratura e per la facilità di aggiornare il controllo senza modificare il circuito

Quando la frequenza di modulazione diventa prossima a quella della V* da generare (pochi impulsi per periodo) il filtraggio del carico si riduce e la forma d'onda della corrente è molto distorta

Quando la frequenza di modulazione diventa prossima a quella della V* da generare (pochi impulsi per periodo) il filtraggio del carico si riduce e la forma d'onda della corrente è molto distorta

In alcuni casi le deformazioni sono accettabili. La PWM può consentire ancora di regolare l'ampiezza della componente fondamentale della tensione

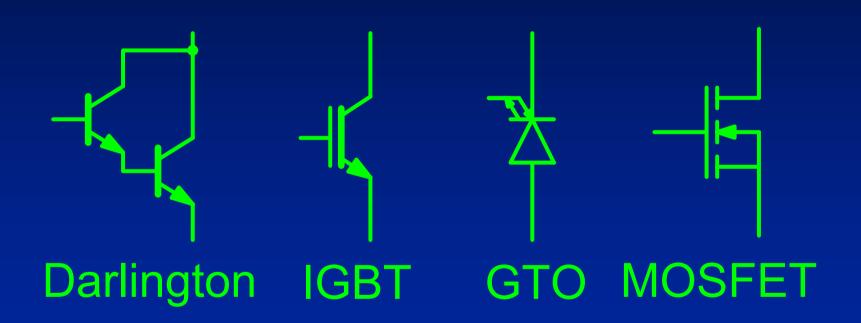
Con un solo impulso per periodo (modulazione ad onda quadra) l'ampiezza della componente fondamentale della tensione generata è fissa e se ne può regolare soltanto la frequenza



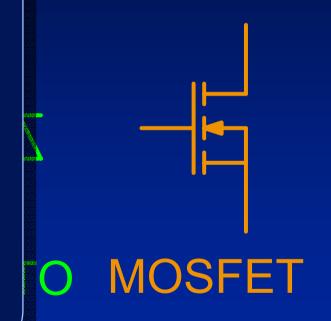
Gli invertitori attuali usano componenti controllati in spegnimento

Gli invertitori attuali usano componenti controllati in spegnimento

Solo per grossissime potenze e in vecchie costruzioni sono ancora usati invertitori a SCR

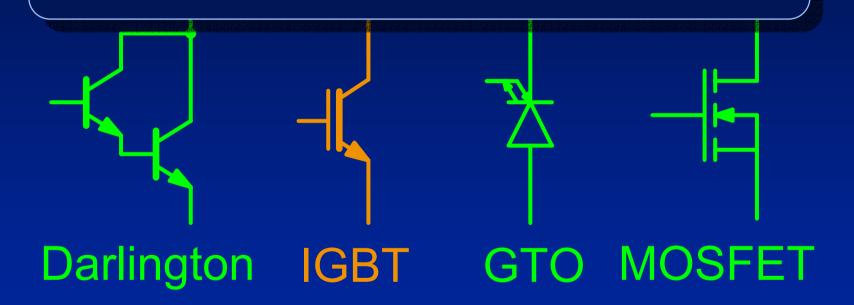


I MOSFET sono quasi esclusivamente usati per piccole potenze, elevate frequenze di commutazione ed applicazioni economiche alimentate dalla rete a 220V

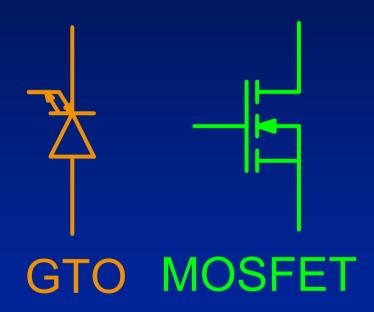




I transistori darlington di potenza sono stati quasi completamente soppiantati dagli IGBT Per le potenze medie/grandi (10-200 kW) si usano prevalentemente IGBT



I GTO sono SCR dotati di capacità di spegnimento. Si usano normalmente per grandi/grandissime potenze (molti MW)



In applicazioni di media potenza si usano spesso moduli comprendenti una o più unità IGBT-DIODO già connessi secondo gli schemi degli invertitori

In applicazioni di media potenza si usano spesso moduli comprendenti una o più unità IGBT-DIODO già connessi secondo gli schemi degli invertitori

Si stanno presentando sul mercato moduli comprendenti anche la circuiteria di comando, che sono convenienti sia dal punto di vista della facilità di realizzazione sia per la maggiore affidabilità

- In applicazioni di media potenza si usano spesso moduli comprendenti una o più unità IGBT-DIODO già connessi secondo gli schemi degli invertitori
- Si stanno presentando sul mercato moduli comprendenti anche la circuiteria di comando, che sono convenienti sia dal punto di vista della facilità di realizzazione sia per la maggiore affidabilità
- Come alternativa ai GTO sono in fase di sviluppo IGBT adatti all'impiego fino a qualche MW